



汕头华汕电子器件有限公司

P N P S I L I C O N T R A N S I S T O R

H369

对应国外型号
BC369

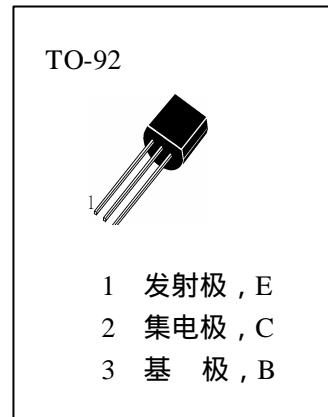
主要用途

功放。

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-65~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	0.83W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-32V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流	- 1A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	$V_{CB}=-25\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-10	μA	$V_{CB}=-25\text{V}, I_E=0, T_a=150^\circ\text{C}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-32		-0.1	μA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_c=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	$I_c=-100 \mu\text{A}, I_E=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_c=-2\text{mA}, I_B=0$
H_{FE}	直流电流增益	85	375			$I_E=-100 \mu\text{A}, I_c=0$
		50				$V_{CE}=-1\text{V}, I_c=-500\text{mA}$
		60				$V_{CE}=-10\text{V}, I_c=-5\text{mA}$
$V_{BE(ON)}$	基极—发射极导通电压			-1	V	$V_{CE}=-1\text{V}, I_c=-1\text{A}$
				-0.7	V	$V_{CE}=-10\text{V}, I_c=-5\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压	40	140	-0.5	V	$I_c=-1\text{A}, I_B=-100\text{mA}$
f_T	特征频率				MHz	$V_{CE}=-5\text{V}, I_c=-50\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$
C_C	集电极电容		28		pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0$ $f=1\text{MHz}$